



中科海高
HiGaAs Microwave

V2.2

HGC212-8

GaAs pHEMT MMIC
6 位数控衰减器, 0.05 - 8 GHz

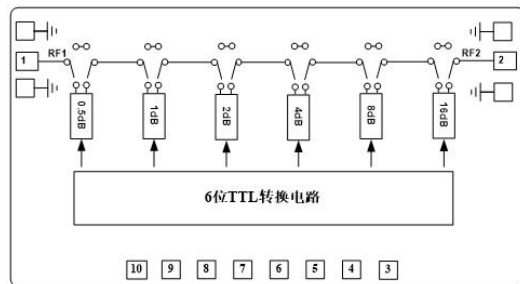
5

衰减器
|
裸芯片

主要特点

全正电控制, 集成 6 位 TTL 电平转换电路
衰减范围: 0.5 dB 至 31.5 dB
衰减精度: ± 0.5 dB
插入损耗: 1.2 dB
供电: +5 V @ 6 mA
芯片尺寸: $1.91 \times 1.1 \times 0.1$ mm³

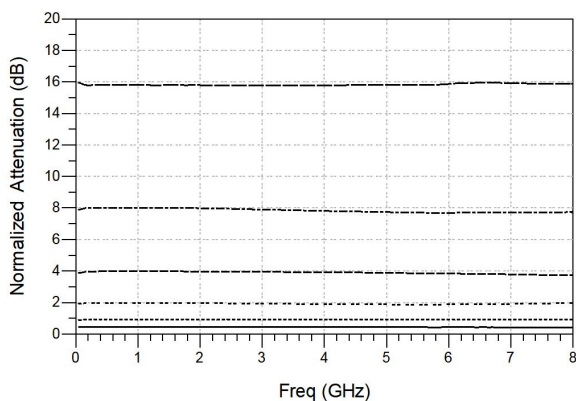
功能框图



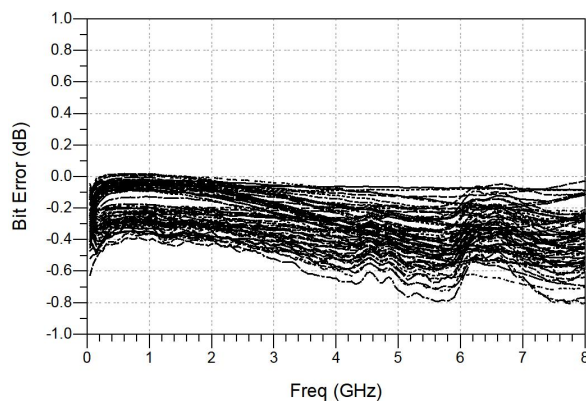
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{CTL} = 0 / +5$ V, $V_{DD} = +5$ V)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围		0.05 - 8		GHz
插入损耗		1.2		dB
衰减精度		± 0.5		dB
衰减附加相移		--		°
回波损耗		15		dB
参考态输入功率 1dB 压缩点@1-8GHz		24		dBm
切换时间		20		ns

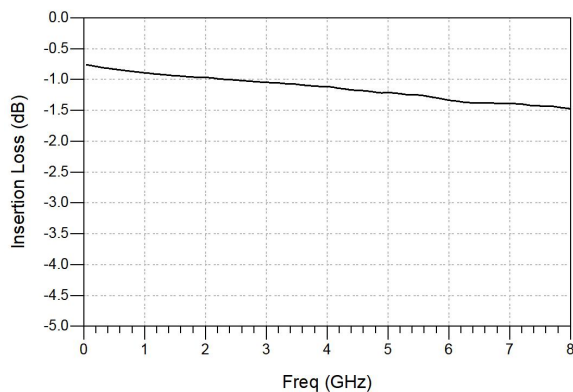
基本态衰减量



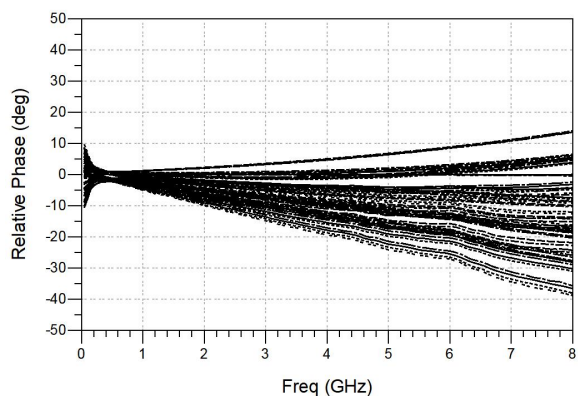
全态衰减精度



插入损耗



全态衰减附加相移

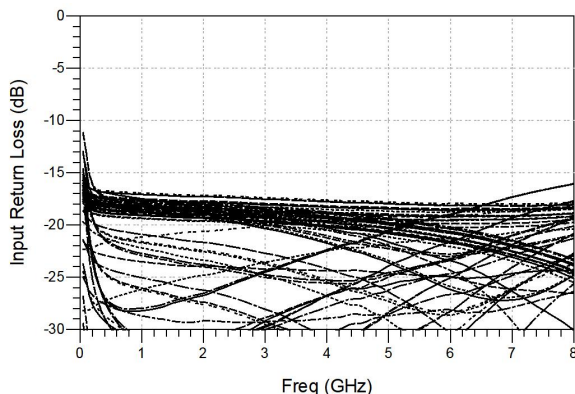


5.21

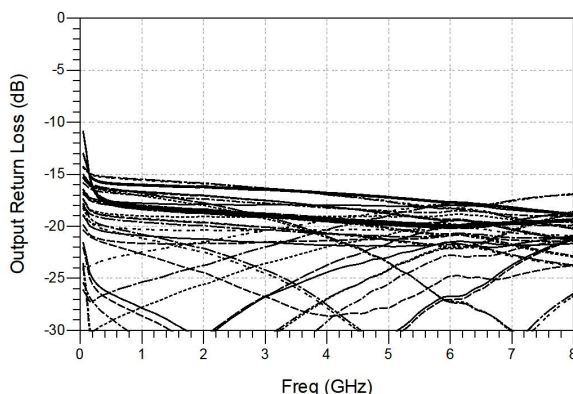
成都市高新区百草路 898 号智能信息产业园 201-203 室
电话: 17313176116 028-64331356 022-66351597

天津市中新生态城中天大道 2018 号科技园 13 号楼 1 层
邮箱: support@higaas.com 网址: www.higaas.com

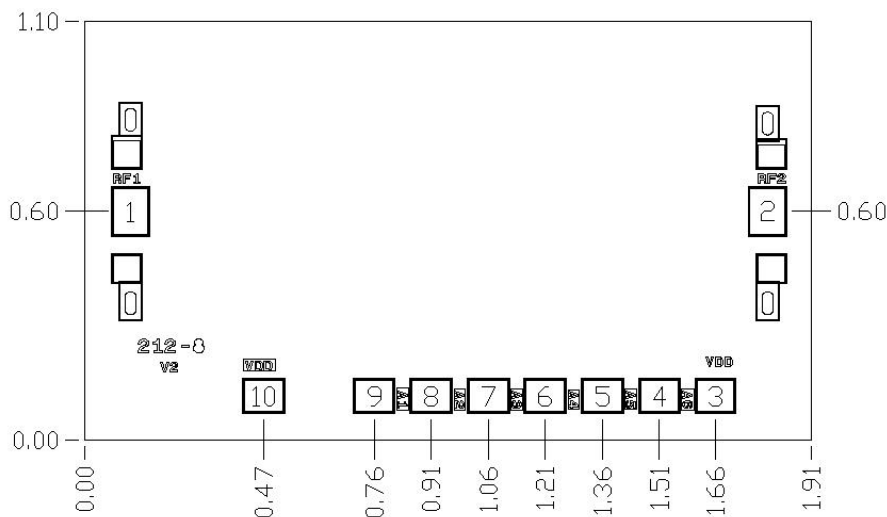
输入回波损耗



输出回波损耗



物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1, 2	RF1, RF2	该焊盘是射频端口, 需要外接隔直电容
3, 10	VDD	该焊盘是 TTL 电平转换电路电源端口, 任选一端接+5V 电源
4	16dB 衰减控制位 A6	A6=0 时 16dB 衰减器关闭, A6=5V 时 16dB 衰减器打开
5	8dB 衰减控制位 A5	A5=0 时 8dB 衰减器关闭, A5=5V 时 8dB 衰减器打开
6	4dB 衰减控制位 A4	A4=0 时 4dB 衰减器关闭, A4=5V 时 4dB 衰减器打开
7	2dB 衰减控制位 A3	A3=0 时 2dB 衰减器关闭, A3=5V 时 2dB 衰减器打开
8	1dB 衰减控制位 A2	A2=0 时 1dB 衰减器关闭, A2=5V 时 1dB 衰减器打开
9	0.5dB 衰减控制位 A1	A1=0 时 0.5dB 衰减器关闭, A1=5V 时 0.5dB 衰减器打开
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

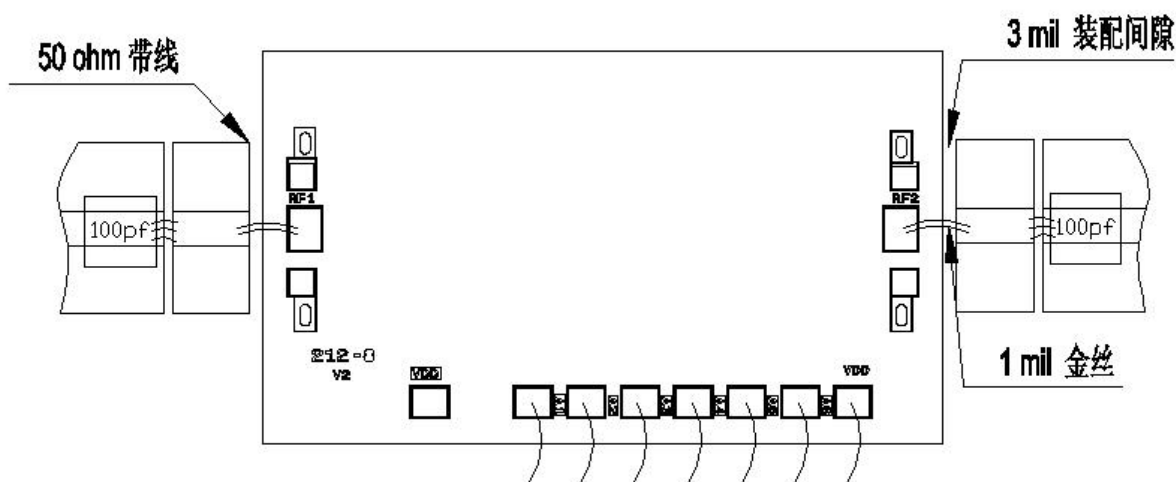


真值表

状态	0.5dB	1dB	2dB	4dB	8dB	16dB
	A1	A2	A3	A4	A5	A6
参考态	0	0	0	0	0	0
0.5dB	1	0	0	0	0	0
1dB	0	1	0	0	0	0
2dB	0	0	1	0	0	0
4dB	0	0	0	1	0	0
8dB	0	0	0	0	1	0
16dB	0	0	0	0	0	1

“0” 电平范围: 0~0.8V; “1” 电平范围: 2.3~5V

推荐装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100 μm
2. 典型键合焊盘尺寸为 100*80 μm^2
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接
7. 控制输入端建议串联 1K 欧姆以上的保护电阻

极限参数

1. 电源电压: +6 V
2. 射频输入功率: +24 dBm
3. 储存温度: -65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
4. 工作温度: -55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$